

# Nb<sub>3</sub>Sn 正常-超导轉变时的比热反常\*

鄭国光 刘体漢 管惟炎  
(中国科学院)

## 提 要

在 16.0°K—20.3°K 之间测量了 Nb<sub>3</sub>Sn 样品的热容量。Nb<sub>3</sub>Sn 在临界温度附近的比热跳跃值  $\Delta C = 2.21(\pm 5\%)$  焦耳/克分子·度。样品的临界温度  $T_c = 17.88^{\circ}\text{K}$ , 转变宽度  $\Delta T_c \approx 0.2^{\circ}\text{K}$ 。由  $\Delta C$  值利用热力学关系式确定了 Nb<sub>3</sub>Sn 在 0°K 时的热力学临界场  $H_0 = 5300$  奥斯特。

利用本文的结果和文献上关于热膨胀系数的跳跃值  $\Delta\alpha$  及  $\partial T/\partial P$  值验证了热力学关系式。

扼要地描述了比热测量装置。

## 一、引 言

在已发现的超导体中, Nb<sub>3</sub>Sn 具有最高的临界温度 ( $T_c \approx 18^{\circ}\text{K}$ )<sup>[1]</sup>。不仅如此, Nb<sub>3</sub>Sn 还是典型的“强磁场超导体”, 在 4.2°K 时, 在高达 88 千奥斯特的强磁场下, 仍能通过很大的超导电流 ( $\approx 10^5$  安/厘米<sup>2</sup>)<sup>[2]</sup>。利用 Nb<sub>3</sub>Sn 已经制成功场强为 101 千奥斯特的超导体螺线管磁体<sup>[3]</sup>。

研究“强磁场超导体”的新近的理论<sup>[4]</sup>和实验<sup>[5]</sup>工作表明: 这类超导体在低电流密度时测得的高临界场和低磁场下的高临界电流密度具有不同的起源。前者取决于样品处于正常态时的电子自由程<sup>[6]</sup>, 而后者则和位错及第二相的出现等有关。必须同时综合考虑 Абрикосов<sup>[6]</sup>的负界面能模型和 Mendelssohn<sup>[7]</sup>的海绵网络模型, 才能正确理解“强磁场超导体”的行为。

在上述重要事实被揭露以后, 我们便不难理解 Лазарев<sup>[8]</sup>等在讨论 Nb<sub>3</sub>Sn 的若干参数之间的热力学关系式时所遇到的困难。

Kunzler<sup>[9]</sup>曾在低电流密度下测定了 Nb<sub>3</sub>Sn 的临界磁场  $H_c$  与温度的依赖关系曲线。在  $T_c$  附近, 曲线的斜率  $\left(\frac{dH_c}{dT}\right)_{T_c} = -15.5 \times 10^3$  奥斯特/度。其后, Лазарев<sup>[8]</sup>等测量了压力对 Nb<sub>3</sub>Sn 临界温度的影响, 他所确定的  $\partial T_c/\partial P$  值为  $-(2.5 \pm 0.3) \times 10^{-5}$  度/大气压<sup>[10]</sup>。

\* 1964 年 6 月 16 日收到。

1) Ицкевич 等 [ЖЭТФ, 45 (1963), 1378] 及 Müller 等 [Rev. Mod. Phys., 36 (1964), 103] 不久前也测量了压力对 Nb<sub>3</sub>Sn 的  $T_c$  的影响。前者的  $\partial T_c/\partial P$  值比 Лазарев 等<sup>[8]</sup>的绝对值小, 而后者却又比 Лазарев 等的数据大六倍多。而且 Ицкевич 等的结果表明  $\Delta T_c (= T_{c,p} - T_{c,0})$  是与压力的平方  $P^2$  成正比的 (从  $\sim 3000$  大气压起)。因此, 目前的实验数据只能判明  $\partial T_c/\partial P$  的数量级, 其精确值有待进一步的更仔细的实验。

按照描述超导体行为的热力学关系式<sup>[10]</sup>

$$\Delta\alpha = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{\partial H_c}{\partial T} \right)_{T_c}^2 \times \left( \frac{\partial T_c}{\partial P} \right), \quad (1)$$

Лазарев 等<sup>[8]</sup>计算了 Nb<sub>3</sub>Sn 在正常超导转变时热膨胀系数的跳跃值  $\Delta\alpha \approx 5 \times 10^{-4}$  度<sup>-1</sup>。这和实际测量结果  $\Delta\alpha = 1.5 \times 10^{-7}$  ( $\pm 10\%$ ) 度<sup>-1</sup> 相差三个数量级<sup>[11]</sup>。按照另一热力学关系式<sup>[10]</sup>

$$\Delta C_{T_c} = \frac{V T_c}{4\pi} \left( \frac{dH_c}{dT} \right)_{T_c}^2, \quad (2)$$

他们还预期 Nb<sub>3</sub>Sn 有很大的比热跳跃值  $\Delta C_{T_c} \approx 1500$  焦耳/克分子·度。

为了克服上述困难, Лазарев等曾经将 Nb<sub>3</sub>Sn 的高临界场  $H$ , 视作是样品中一小部分体积的行为。现在已经知道, 更正确的解释是: Nb<sub>3</sub>Sn 属于 Абрикосов<sup>[6]</sup> 理论中所提出的所谓“第二类超导体”, 因此, 电导测量所确定的临界场  $H_r$  比热力学临界场  $H_c$  要大很多, 而  $H_r$  看来更近于  $H_{c2}$  (“第二类超导体”完全失却逆磁性的临界场)。

“第二类超导体”的热力学临界场原则上可以用磁测量确定。但是, Bozorth<sup>[12]</sup>的实验磁化曲线是不可逆的, 样品内有局部应力引起的冻结磁矩。在这种情况下, 简单地利用 Абрикосов 负界面能模型来由磁化曲线计算热力学临界场是不正确的, 因为在实际样品中, 在均匀的理想“第二类超导体”的基底上, 还存在由各类缺陷引起的“海绵网络”, 在磁测量中, 它们使样品具有复连通体的某些行为<sup>[13]</sup>, 而在电导测量中它们增大了样品的临界电流<sup>[5]</sup>。由积分磁化曲线下的面积而确定的临界场显然会偏大。

由上面的讨论可以看出, 尽管 Nb<sub>3</sub>Sn 是重要的强磁场磁体的材料, 关于它的某些重要的基本参数, 如热力学临界场  $H_c$ , 迄今仍未能确定; 而描述超导体行为的热力学关系式是否适用于象 Nb<sub>3</sub>Sn 这类超导体, 也有待验证。

我们在 16.0—20.3°K 间测定了 Nb<sub>3</sub>Sn 样品的热容量, 并由此确定了正常-超导转变时的比热跳跃值。利用公式(2)及  $H_c$  对温度依赖关系的假定, 确定了 Nb<sub>3</sub>Sn 在绝对零度时的热力学临界场。利用本文实验结果和文献[8, 11]的数据, 讨论了 Nb<sub>3</sub>Sn 的热力学行为。

## 二、样品制备

将原子比为 3:1 的 Nb 粉及 Sn 粉(其细粉均能通过 230 目的筛孔)均匀混合, 在每平方厘米 4 吨的压力下压成圆柱筒。Nb 粉的纯度为 99.5%, Sn 粉的纯度为 99.995%。样品密封在抽空的石英管内进行烧结, 先在 950°C 保温 8 小时, 然后再升到 1000°C 保温 16 小时, 以获得充分反应的 Nb<sub>3</sub>Sn。烧结后样品重 34.235 克(由于 Sn 的挥发, 样品在烧结过程中失重 0.223 克)。圆筒外径 19.8 毫米, 内径 5.3 毫米, 高为 24.9 毫米, 密度为 4.8 克/立方厘米。X 射线粉末照相表明, 样品具有  $\beta$ -W 型结构, 没有发现杂质条。

## 三、实验装置

样品(图 1, 12)外表面绕以直径 0.08 毫米、长 8 米的锰铜加热线(14), 采用无自感绕法, 其室温电阻值为 650 欧姆。样品与加热线之间的热接触由粘接用的 БФ-2 胶提供。碳电阻温度计(13)放在样品的中空部分, 其外径比圆筒样品的内径略小, 间隙间填以高真空

活塞油,以保証样品与温度計之間有較好的热接触。温度計的室温电阻值为 85 欧姆。用尼龙絲(7)将样品悬掛在热屏頂盖(9)上。

样品周围圍以壁厚为 0.5 毫米的紫銅热屏。热屏由頂蓋及主体(10)两部分組成,样品悬掛好后两者用螺釘(8)連接。热屏也用尼龙絲悬掛在真空室的封蓋上(3)。在样品与热屏之間的电引綫(温度計有四根,加热絲有两根)由直径 0.08 毫米、长 4 厘米的一段錳銅綫作成。这些引綫在接到热屏上后再和同样直径的銅引綫焊接(并且,加热絲的引綫也增加到四根)。热屏的外圓柱面上均匀地刻着 12 条深 0.2 毫米的纵向槽。从样品引出的所有引綫均用 БФ-2 胶粘貼在槽內,以取得热屏的温度(为清楚起見,图 1 中未画出引綫的連接部分)。热屏頂蓋、底部和圓柱面的外表面上都均匀地繞有錳銅加热絲(11)。銅-康銅差分热电偶指示样品与热屏的温差。热电偶的两根銅引綫由真空室引出后接在灵敏检流計的接綫柱上(检流計的电压灵敏度为  $5 \times 10^{-8}$  伏/毫米/米)。靠改变热屏上加热器中通过的电流控制热屏的温度,使检流計指示不偏离零点。

真空室外壳(6)由紫銅制成,它与真空室封蓋(3)用伍德合金焊接。真空室內径 68 毫米,壁厚 1 毫米。封蓋上焊有直径 30 毫米、厚 3 毫米的紫銅圓盤(5),以防止杜瓦瓶頂部的热輻射直接进入真空室內。焊在封蓋上的薄壁德銀管(1)支持整个真空室重量,并作为抽气管道。

所有电測量導綫(2)由热屏上引出后,在真空室封蓋凸部的圓环(4)上紧繞数圈,并用 БФ-2 胶与圓环粘接以提供充分的热接触。導綫經過德銀管(1)引到杜瓦瓶頂部。每根導綫分別穿过德銀管頂端的橡皮塞(图 2),由橡皮塞及黃銅螺蓋保証真空密封。

真空系統如图 2 所示,由机工抽机(5 立方米/时)、金属油扩散泵(50 升/秒)、液氮冷阱、电离真空計灯泡及氯气储气瓶等組成。比热測量时系統內能保持  $10^{-6}$  毫米汞柱的真空。

量热真空室浸在盛有液态氢的杜瓦瓶內。为了改变和測量液态氢的温度,杜瓦瓶分別和減压抽机(9 立方米/时)及水銀压力計相連接。

样品加热功率用两台国产 P-591 型电位計測量,其一测量样品加热綫上通过电流时的电压降  $U_R$ ,另一电位計同时测量与样品加热綫串联的标准电阻  $R_H$  上的电压降  $U_H$ 。加热時間由电秒表讀出,由一个双刀双擲开关同时接通或切断加热迴路及电秒表的繼电器迴路。加热电源为鉛蓄電池。在停止加热期間,蓄電池在与加热絲有相同电阻值的另一迴路上繼續放电,以保証电源电压的稳定性。

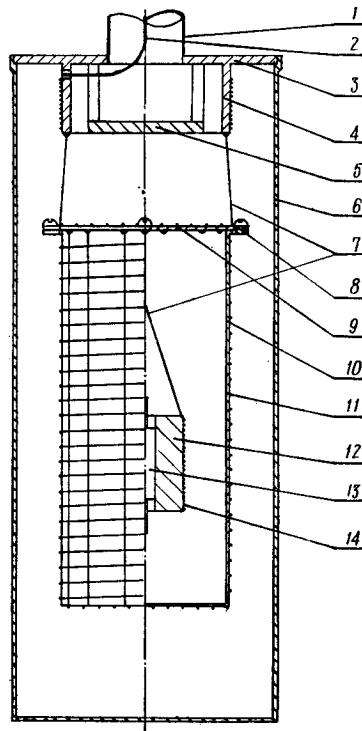


图 1 真空量热室

1. 德銀管, 2. 测量導綫, 3. 真空室封蓋,  
4. 封蓋凸部, 5. 防輻射圓盤, 6. 真空室  
外壳, 7. 尼龙絲, 8. 螺釘, 9. 热屏頂蓋,  
10. 热屏主体, 11. 热屏 加热絲, 12.  
Nb<sub>3</sub>Sn 样品, 13. 碳電阻溫度計, 14. 样  
品加热线。

碳电阻温度計的电阻值用 KJL-48 型电位計配合 Kipp A15 型灵敏检流計来測定，測量电流为 50 微安。在本文測量溫度范围内，可測最小溫度改变值为  $3-5 \times 10^{-4}$  K。

热屏的加热电源由鉛蓄電池供給。

順便提一下，本装置在改用鉛电阻温度計后，可以測定  $12-300$  K 間的比热值。样品为一克分子时，在整个温区内測量精度可达 1%。

#### 四、比热測量

在測量样品热容以前，首先用氫蒸汽压溫度計对碳电阻温度計进行标定。

真空室抽空后充入低压干燥氮气，然后向杜瓦瓶內輸入液态氮。在系統达到热平衡后，同时测定氫蒸汽压及碳电阻的电阻值。测定液氫飽和蒸汽压用的水銀压力計的压差由測高仪讀出。

溫度計标定的結果表明，我們所采用的碳电阻的标定曲綫符合 Clement 等人<sup>[14]</sup>提出的公式：

$$\log R + \frac{K}{\log R} = A + \frac{B}{T}.$$

图 2 比热测量系统示意图  
 1. 氮气储气瓶，2. 金属油扩散泵，3. 金属真空开关，4. 玻璃活塞开关，5. 液氮冷阱，6. 抽气管道，7. 电离真空计灯泡，8. 真空密封接头，9. 引线出口橡皮密封，10. 接线柱，11. 杜瓦瓶顶盖，12. 德银管，13. U 形水銀压力計，14. 液氫杜瓦瓶，15. 液氮杜瓦瓶，16. 真空量热室，17. 減压机工抽机，18. 前级机工抽机。

在  $18^{\circ}\text{K}$  附近，由电阻值及上式定出之溫度与由蒸汽压讀出之溫度相差小于  $0.01^{\circ}\text{K}$  (所有溫度測量均假定液氫为正常氫，由此引起的溫度偏差未估計在內)。

溫度計标定完毕后将热交換气体抽走，使真空达到  $10^{-6}$  毫米汞柱，以保証比热測量所必須的真空条件。

測量开始时利用碳电阻温度計和停表來觀察样品的溫度变率，調節热屏溫度使溫度变率成为常值，且小于  $5 \times 10^{-4}$  K/分。以当时热电偶电流計光点指示所在位置作为热屏与样品間溫差指示的零点。样品加热期間及停止加热后均隨時調節热屏溫度，使溫差指示維持在零点位置。

样品加热期間同时用两台 P-591 型电位計測量加热功率。加热線引線的电阻占加热線总电阻的 0.99%，在計算加热量时，假定此段电阻所产生焦耳热的一半被送到样品上。样品加热持續時間  $\Delta t$  約为 30 秒鐘，停止加热后在半分鐘內样品可以达到热平衡状态。样品开始加热时所測溫度值表作  $T_1$ ，样品处于热平衡状态后（此时样品的溫度变率也小于  $5 \times 10^{-4}$  K/分）所測溫度值表作  $T_2$ ，通常溫升  $\Delta T = T_2 - T_1$  选取  $0.06^{\circ}\text{K}$  左右。

由实验測定的数据按下式計算样品的热容量：

$$C(\bar{T}) = \frac{804}{808} \times \frac{U_H U_R \Delta t}{R_H(T_2 - T_1)} \text{ 焦耳/度},$$

其中  $U_H$  和  $U_R$  分別是标准电阻和加热線上的电压降(伏特)， $R_H$  是标准电阻之电阻值(欧姆)，系数  $804/808$  是样品加热線有效电阻值与总电阻值之比，而  $\bar{T}$  是加热前后的平均溫

度:  $\bar{T} = \frac{T_2 + T_1}{2}$ .

由于采用较小的温度变率及上述控制热屏的方法, 在计算样品热容量时我们没有对样品温升  $\Delta T$  进行漏热修正。

测量结果由图 3 表示, 它给出所测 Nb<sub>3</sub>Sn 样品热容量与温度的关系。样品的热容值中实际上还包括碳电阻温度计(重 0.991 克), 钴铜加热线(重 0.473 克), BΦ-2 胶(重 0.362 克) 及真空活塞油的热容值在内。计算表明这些附属物的热容值约占总热容值的 10%。由于本文所关心的是  $T_c$  附近 Nb<sub>3</sub>Sn 的比热跳跃值, 因此没有必要进行附属物热容量的修正。

由图 3 可见, Nb<sub>3</sub>Sn 样品的比热值在正常-超导转变时发生跳跃。跳跃发生在临界温度  $T_c = 17.88^\circ\text{K}$  附近, 而正常-超导转变的转变宽度约为  $0.2^\circ\text{K}$ 。Nb<sub>3</sub>Sn 在正常-超导转变时的比热跳跃值为  $\Delta C = 2.21(\pm 5\%)$  焦耳/克分子·度( $\Delta C$  值是由图 3 按下述方法计算出的: 在  $17.88^\circ\text{K}$  处作垂直于温度坐标轴的垂线, 其上、下两端分别与样品超导态及正常态的热容曲线的延缓相交, 交点间的截距除以 Nb<sub>3</sub>Sn 样品的克分子量后即得比热跳跃值)。

实验点的散度(与圆滑曲线的偏离)一般在 2% 以内, 但有个别实验点偏离超过 2%。误差的主要来源是样品温度的测量。

## 五、討論

1. 由我们的实验结果及公式(2), 可以计算 Nb<sub>3</sub>Sn 在  $T_c$  附近临界磁场-温度关系曲线的斜率:

$$\left(\frac{dH_c}{dT}\right)_{T_c} = 590 \text{ 奥斯特/度},$$

如果认为  $H_c(T)$  曲线近似地可以用抛物线

$$H_c = H_0 \left[ 1 - \left( \frac{T}{T_c} \right)^2 \right]$$

来描述, 则 Nb<sub>3</sub>Sn 在绝对零度时的临界场

$$H_0 = 5300 \text{ 奥斯特}.$$

Kunzler<sup>[9]</sup>用电导测量所定的临界场  $H_c(0^\circ\text{K}) = 183$  千奥斯特。两者之比  $H_r(0^\circ\text{K})/H_0 \approx 35$  倍, 和 Mo<sub>3</sub>Re 及 Nb-Zr 的情况相似<sup>[18] 1)</sup>。

积分 Bozorth<sup>[12]</sup>等测量的磁化曲线下的面积可以确定一  $H_c$  值:  $H_c(4.2^\circ\text{K}) \approx 15 \times 10^3$  奥斯特。很显然, 这比真正的热力学临界场要大很多。只有当样品的磁化过程是完全可

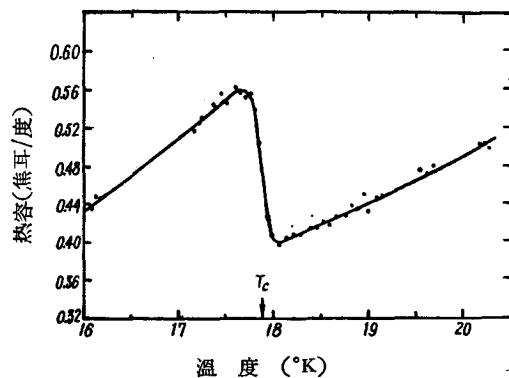


图 3 Nb<sub>3</sub>Sn 样品在正常-超导转变时热容与温度的关系曲线

1) 文献[18]中曾定出 Nb<sub>3</sub>Sn 的  $H_r(4.2^\circ\text{K})/H_c(4.2^\circ\text{K})$  为 33, 但所采用的  $H_c(4.2^\circ\text{K}) \approx 6000$  奥斯特比较任意。

逆时,才能用磁测量方法确定热力学临界场。

实际的强磁场超导体都不是理想的“第二类超导体”,它们的临界场只有靠量热的方法才能由实验确定。

2. 在公式(1)及(2)中消去  $\left(\frac{\partial H_c}{\partial T}\right)_{T_c}^2$  后可以引出下列关系式:

$$\Delta C = \frac{V T_c \Delta \alpha}{(\partial T_c / \partial P)},$$

将  $\Delta \alpha$  及  $\partial T_c / \partial P$  的实验值代入上式,取 Nb<sub>3</sub>Sn 的克分子体积  $V = 44.48$  厘米<sup>3</sup>/克分子,可以算出  $\Delta C$  值:  $\Delta C = 0.48$  焦耳/克分子·度。这和我们的实验结果  $\Delta C = 2.21$  焦耳/克分子虽然仍差 4 倍,但已是同一个数量级。由于  $\partial T_c / \partial P$  及  $\Delta \alpha$  的测量误差可能很大<sup>1)</sup>,看来可以认为 Nb<sub>3</sub>Sn 的各参数是满足热力学关系式的。

3. Morin 等<sup>[15]</sup>曾经用脉冲加热法在很小的样品上测量了 Nb<sub>3</sub>Sn 的比热,但没有给出有关  $\Delta C$  的结果。他的样品的临界温度  $T_c = 17.3^\circ\text{K}$  和其他作者<sup>[1, 16, 17]</sup> 及本文所确定的  $T_c$  值相比要低很多,可以大胆认为, Morin 的样品是有问题的(作者没有给出制备条件)。因此,他的比热数据比本文测定值小并不说明存在严重的分歧。

4. 超导体的正常电子比热系数  $\gamma$  与  $\Delta C$  及  $T_c$  之间存在下列关系式:

$$\gamma = \alpha \times \frac{\Delta C}{T_c}.$$

按照 Gorter-Gasimir 的二流体模型<sup>[19]</sup>,  $\alpha = 0.5$ , 而按照 BCS 理论<sup>[20]</sup>, 则  $\alpha = 0.658$ 。由此定出的  $\gamma$  值分别为 62 及 81 毫焦耳/克分子·度<sup>2)</sup>。前者和 Morin<sup>[15]</sup>的结果很相近。

5. 利用 Горьков<sup>[21]</sup>的关系式

$$H_{c2}(0^\circ\text{K}) = 1.77 \kappa H_0,$$

可以估计 Nb<sub>3</sub>Sn 的  $\kappa$  值。若取  $H_{c2}(0^\circ\text{K}) \approx 200$  千奥斯特, 则由本文所确定的  $H_0$  估算的  $\kappa = 21$ , 由此可见, Nb<sub>3</sub>Sn 确系典型的“第二类超导体”。

洪朝生先生对本文提出了一些宝贵意见;李世恕、赵海源、冉启泽、刘仁等同志先后参加了建立比热测量设备的工作;低温车间的同志提供了充分的液氢,作者们对他们表示深切的谢意。

### 参 考 文 献

- [1] Matthias, B. T., Geballe, T. H., Geller, S. and Corenzwit, E., *Phys. Rev.*, **95** (1954), 1435.
- [2] Kunzler, J. E., Buehler, E., Hsu, F. S. L. and Wernick, J. H., *Phys. Rev. Letters*, **6** (1961), 89.
- [3] Martin, D. L., Benz, M. G., Bruch, C. A. and Rosner, C. H., *Cryogenics*, **3** (1963), 161.
- [4] Anderson, P. W., *Phys. Rev. Letters*, **9** (1962), 309.
- [5] 张其瑞、曹效文、管惟炎, 物理学报, **20** (1964), 568.
- [6] Абрикосов, А. А., ЖЭТФ, **32** (1957), 1442.
- [7] Mendelsohn, K., *Proc. Roy. Soc.*, **152A** (1935), 34.
- [8] Лазарев, Б. Г., Лазарева, Л. С., Овчаренко, О. Н., Мацакова, А. А., ЖЭТФ, **43** (1962), 2309.
- [9] Kunzler, J. E., *J. Appl. Phys. Suppl.*, **33** (1962), 1042.
- [10] Shoenberg, D., *Superconductivity*, Cambridge at the University Press. (1952), p. 75, 60.
- [11] Лазарев, Б. Г., Лазарева, Л. С., Судовцов, А. И., Алиев, Ф. Ю., ЖЭТФ, **43** (1962), 2312.

1) 例如,在文献[8, 11]中所用的样品都是靠 Nb 表面的反应扩散引起的,其反应的完善程度十分可疑。并且,关于  $\partial T_c / \partial P$  的数据文献上分歧很大。

- [12] Bozorth, R. M., Williaws, A. J. and Davis, D. D., *Phys. Rev. Letters*, **5** (1960), 148.
- [13] Livingston, J. D., *J. Appl. Phys.*, **34** (1963), 3028.
- [14] Clement, J. R. and Quinnell, E. H., *Rev. Sci. Instrum.*, **23** (1952), 213.
- [15] Morin, F. J. and Maita, J. P., *Phys. Rev.*, **129** (1963), 1115.
- [16] Ланге, Ф. К., *ЖЭТФ*, **42** (1962), 42.
- [17] Junsen, H. G. and Saur, E. J., Proc. of the VII-th Intern. Conf. on Low Temp. Phys., edited by G. M. Graham and A. C. Hollis Hallett (1961), p. 379.
- [18] Blaugher, R. D. and Hulm, J. K., *Phys. Rev.*, **125** (1962), 474.
- [19] Gorter, C. J. and Gasimir, H. B. G., *Phys. Z.*, **35** (1934), 963.
- [20] Bardeen, J., Cooper, L. N. and Schrieffer, J. R., *Phys. Rev.*, **108** (1957), 1175.
- [21] Горьков, Л. П., *ЖЭТФ*, **37** (1959), 833.

## SPECIFIC HEAT ANOMALY OF Nb<sub>3</sub>Sn AT THE NORMAL-SUPERCONDUCTING TRANSITION

CHENG GUO-KUANG LIU TI-HANG KUAN WEI-YEN

(Academia Sinica)

### ABSTRACT

The heat capacity of Nb<sub>3</sub>Sn has been measured between 16.0°K and 20.3°K. A jump in specific heat at  $T_c$  is found with  $\Delta C = 2.21 (\pm 5\%)$  joule/mole·deg. The transition temperature of the sample is  $T_c = 17.88^\circ\text{K}$ , and the transition interval is  $\Delta T_c \approx 0.2^\circ\text{K}$ . From the measured  $\Delta C$  and by using the thermodynamic relationship, the thermodynamic critical magnetic field at 0°K,  $H_0 \approx 5300$  Oe, was obtained.

Using the result of  $\Delta C$  obtained in the present work, and the jump of the thermo-expansion coefficient  $\Delta\alpha$  and  $\frac{\partial T_c}{\partial p}$  from the literatures, the thermodynamic relation between these quantities was found to be valid.

Apparatus for measuring the specific heat is briefly described.